



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HC114E

对应国外型号
DTC114E, 2SC3402, KSR1202

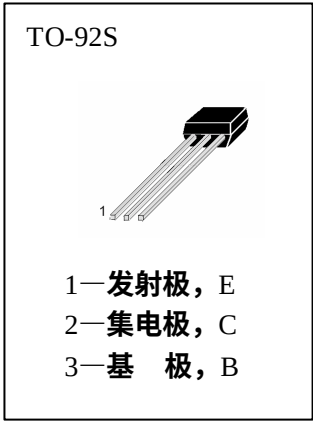
主要用途

开关、接口电路等。

极限值 (T_a=25°C)

T _{stg}	— 贮存温度	-55~150°C
T _j	— 结温	150°C
P _C	— 集电极耗散功率	300mW
V _{CBO}	— 集电极—基极电压	50V
V _{CEO}	— 集电极—发射极电压	50V
V _{EBO}	— 发射极—基极电压	10V
I _C	— 集电极电流	100mA

外形图及引脚排列



电参数 (T_a=25°C)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	50			V	I _C =10 μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	50			V	I _C =0.1mA, I _B =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V _{CB} =40V, I _E =0
I _{CEO}	集电极—发射极截止电流			0.5	μA	V _{CE} =40V, I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流	195	250	360	μA	V _{EB} =5V, I _C =0
H _{FE}	直流电流增益	30				V _{CE} =5V, I _C =5mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		0.1	0.3	V	I _C =10mA, I _B =0.5mA
V _{I(off)}	关闭输入电压	0.8	1.1	1.5	V	V _{CE} =5V, I _C =0.1mA
V _{I(on)}	导通输入电压	1.0	2.0	4.0	V	V _{CE} =0.2V, I _C =10mA
R ₁	输入电阻	7.0	10	13	kohm	
R _{1/R2}	电阻比值	0.8	1.0	1.2		
f _T	特征频率		250		MHz	V _{CE} =10V, I _C =5mA